Nachname	Vorname(n)	Matrikelnummer

Schriftliche Prüfung 25. Februar 2011

Passive Bauelemente

Der Beginn der Prüfung wird von der Prüfungsaufsicht bekannt gegeben. Wenn Sie vor dem offiziellen Beginn diese Seite umschlagen und die Aufgaben einsehen, wird dies als Täuschungsversuch gewertet. Füllen Sie folgenden Kasten vollständig aus.

Nachname	Vorname	Matrikelnummer
	Zutreffendes bitte ankreuzen ☐ Erstprüfung ☐ Wiederholungsprüfung	EDV-Nummer
Wiederholer/innen bitte ausfüllen		
Straße/Nummer	Postleitzahl/Ort	
Telefon	E-Mail	

Zur Prüfung zugelassene / mitzubringende Hilfsmittel

- Es sind keine Hilfsmittel außer den angegebenen erlaubt.
- Formelsammlung f
 ür PB SS 2010 (ohne handschriftliche Notizen)
- Zwei handschriftlich (einseitig) beschriebene DIN-A4-Seiten
- Taschenrechner und Schreibzeug (Lineal, Stifte etc., keine Bleistifte verwenden)

Hinweise zum Ablauf der Prüfung

- Halten Sie Ihren Studierendenausweis und Ihre Immatrikulationsbescheinigung bereit.
- Nach Prüfungsbeginn kontrollieren Sie bitte zuerst, ob das vorliegende Prüfungsheft vollständig ist.
- Die Prüfungsdauer beträgt 3 Zeitstunden.
- Jegliche Kommunikation ist während der Prüfung untersagt.
- Während der Prüfung werden Fragen zu Aufgaben oder Stoffgebiet nicht beantwortet.
- Beachten Sie Tafelanschriebe und Folien, die zu Beginn oder während der Prüfung gezeigt werden.

Hinweise zum Bearbeiten der Aufgaben

- Die Prüfung besteht aus 30 Antwort-Wahl-Fragen (Teil 1) und 3 Rechenaufgaben (Teil 2). In den beiden Teilen sind jeweils 30 Punkte erreichbar.
- Falls Ihnen die deutsche Sprache Schwierigkeiten bereitet, können Sie Begründungstexte alternativ in englischer Sprache formulieren.
- Wenn Sie den Unterpunkt einer Rechenaufgabe nicht gelöst haben, rechnen Sie mit den angegebenen Größen / Zahlenwerten weiter.
- Lösungen auf eigenen Blättern, unzureichend gekennzeichnete Lösungen und Lösungen auf Blättern ohne Angabe von Name, Matrikelnummer oder Aufgabennummer werden nicht gewertet.
- Für die Lösung ist der dafür vorgesehene Bereich unterhalb der jeweiligen Aufgabenstellung zu verwenden. Falls der vorhandene Platz nicht ausreichen sollte, verwenden Sie das hinten beigefügte Zusatzblatt. Bei Bedarf werden von der Prüfungsaufsicht weitere Blätter ausgegeben. Für jede Aufgabe muss eine separate Zusatzseite verwendet werden. Sind auf einer Seite Teile mehrerer Aufgaben gelöst worden, wird entsprechend der Aufgabennummer in der Kopfzeile gewertet.
- Die Ergebnisse und Begründungen sind in die dafür vorgesehenen Bereiche, Felder oder Diagramme zu schreiben bzw. anzukreuzen. Beschriften Sie keinesfalls die grau hinterlegten Korrekturfelder.

Viel Erfolg!

Nachname	Vorname(n)	Matrikelnummer

Teil 1: Antwort-Wahl-Fragen (30 Punkte)

Bei den folgenden Antwort-Wahl-Fragen können jeweils eine oder mehrere Antworten richtig sein. Es wird je Frage 1 Punkt vergeben, wenn genau alle richtigen Antworten und keine falschen Antworten angekreuzt sind. Teilpunkte werden nicht vergeben.

1.	Schottkydefekte treten □ bei höheren Temperaturen in höherer Konzentration auf. □ ausschließlich in Ionenkristallen auf. □ ausschließlich in rein kovalent gebundenen Kristallen auf. □ sowohl in Einkristallen als auch in polykristallinen Werkstoffen auf.
2.	Der Anstieg der Frenkel-Defekt-Konzentration ☐ hat eine Volumenvergrößerung des Kristalls zur Folge. ☐ ändert die Dichte des Materials nicht. ☐ ist direkt proportional zur absoluten Temperatur.
3.	In Ionenkristallen □ treten positiv geladene Kationen und negativ geladene Anionen auf. □ tritt keine Leitfähigkeit auf (Isolatoren), da alle Ladungsträger an die Ionen gebunden sind. □ sind Punktdefekte in der Regel elektrisch geladen (relativ zum ungestörten Idealgitter). □ können nur Elemente der 1. und 17. Gruppe als Bausteine vorkommen.
4.	Der Wärmetransport zwischen zwei Festkörperproben ☐ findet bei sehr hohen Temperaturen überwiegend durch Wärmestrahlung statt. ☐ erfolgt im Vakuum über Phononen. ☐ funktioniert in einem gemeinsamen Medium auch über Konvektion. ☐ lässt sich auch durch einen Entropiestrom vom kälteren zum wärmeren Körper beschreiben.
5.	Die quantentheoretisch erlaubten Zustände in einem Atom □ werden mit jeweils 2 Elektronen mit unterschiedlichem Eigendrehimpuls besetzt. □ werden in der Reihenfolge ihrer Hauptquantenzahl n = 1, 2, 3 besetzt. □ werden nach dem Pauli-Prinzip besetzt. □ werden in der Reihenfolge ihrer Energieniveaus besetzt.
6.	Die Wärmeleitung in Festkörpern erfolgt ☐ in Ionenkristallen überwiegend durch Phononen. ☐ in Metallen überwiegend durch Phononen. ☐ in kovalent gebundenen Festkörpern überwiegend durch Elektronen. ☐ in Metallen überwiegend durch Elektronen.
7.	 Bei der Diffusion von Fremdatomen aus der Gasphase in einen Festkörper □ sorgt das Konzentrationsgefälle zwischen Oberfläche und Probeninnerem für einen Teilchenstrom, der durch das 1. Ficksche Gesetz beschrieben wird. □ ist die Eindringtiefe temperaturunabhängig. □ ist die Eindringtiefe eine Funktion der Zeit. □ wird nach unendlicher Zeitdauer eine Gleichverteilung in der gesamten Probe erreicht

8.		haben keine Vorzugsrichtung (isotropes Verhalten). haben eine Vorzugsrichtung (anisotropes Verhalten). haben keinen streng periodischen Aufbau.
9.		einer chemischen Reaktion ist ein Gleichgewicht erreicht, wenn sich die chemischen Potentiale der Reaktionspartner nicht mehr ändern. gibt das Massenwirkungsgesetz an, in welchem Verhältnis die Gleichgewichts-Konzentrationen der beteiligten Reaktionspartner zueinander stehen. gibt das Massenwirkungsgesetz an, wie groß die Gesamtmassen der beteiligten Stoffe im Gleichgewicht sind.
10.		e elektrische Leitfähigkeit in Festkörpern erfolgt in Metallen durch Phononen. bei kovalenter Bindung durch Ionen. in Halbleitern durch Elektronen und Defektelektronen. in Ionenkristallen durch Elektronen und/oder Ionen
11.		elche Aussagen zur Polarisation sind richtig? Die Ionenpolarisation kann durch eine Serienresonanz modelliert werden. Die Orientierungspolarisation kann bis in den THz-Bereich genutzt werden. Die elektronische Polarisation bei Gasen nimmt mit dem Atomradius zu.
12.		Niob bzw. Tantal Elektrolytkondensator darf nur unipolar betrieben werden. nutzt überwiegend das große ε_r dieser Metalloxides ($\varepsilon_r > 200$) zur Realisierung großer Kapazitäten. nutzt die sehr dünnen Oxidschichten und die große Oberfläche zur Realisierung großer Kapazitäten.
13.		r Verlustfaktor $tan(\delta)$ eines realen Kondensators ist ein Maß für die Abweichung des Kondensators vom rein kapazitiven Verhalten. unabhängig von der Güte des Kondensators. frequenzabhängig.
14.	lad □ □	Einschichtkondensator mit ferroelektrischem Dielektrikum wird bei einer Temperatur $T < T_C$ aufgeen und von der Spannungsquelle getrennt. Beim Erwärmen des Kondensators auf $T >> T_C$ steigt die Spannung an. bleibt die Spannung gleich. sinkt die Spannung ab.
15.		tallische Leiter besitzen nur bei $T=0$ K ein voll besetztes Leitungsband. können eine Fermi-Energie W_F besitzen, die gleichzeitig sowohl im Leitungs- als auch im Valenzband liegt. weisen eine konstante, temperaturunabhängige Ladungsträgerkonzentration auf. besitzen bei $T=0$ K einen spezifischen Widerstand, der von den im Werkstoff vorhandenen Defekten, Verunreinigungen und Fremdatomen bestimmt wird.
16.		elche Aussagen zu nichtlinearen Widerständen und den verwendeten Materialien sind richtig? Heißleiter haben einen negativen Temperaturkoeffizienten des el. Widerstands. Heißleiter basieren auf Korngrenzphänomenen. Kaltleiter haben einen negativen Temperaturkoeffizienten des el. Widerstands.

Na	nchname	Vorname(n)	Matrikelnummer
17.	Heißleiter (NTC) können eingesetzt □ zur Temperaturmessung. □ zur Spannungsstabilisierung. □ zur Einschaltverzögerung.	werden:	L
18.	Bariumtitanat (BTO) und PTC-Effek ☐ Bariumleerstellen wirken an den ☐ Sauerstoffleerstellen wirken in B ☐ Die Grundleitfähigkeit in BTO b	Korngrenzen als intrinsische Akzeptoren TO als Akzeptoren.	
19.	□ bestehen aus polykristallinen Weder Körner in Abhängigkeit von	nsprechspannung von der Anzahl der zwis	-
20.	Kaltleiter (PTCs) ☐ besitzen einen konstanten Tempe ☐ bestehen aus halbleitenden, poly temperaturabhängige Potentialba ☐ werden als selbstregelnde Heizel	kristallinen Ferroelektrika, die an den Koarrieren aufweisen.	rngrenzen
21.	Ein NTC-Widerstand ohne Wärmeableitung wird an eine Spannungsquelle angeschlossen. Wie verhält sich der Strom mit der Zeit? ☐ Der Strom fällt exponentiell ab. ☐ Der Strom steigt bis zur Zerstörung des Bauteils an. ☐ Der Strom bleibt konstant.		
22.	Welche Aussage zu Supraleitern ist n ☐ "HTSC" lassen sich mit flüssigen ☐ Cooper-Paare existieren nur unte ☐ Beim Supraleiter 2. Art dringt de	m Stickstoff (<i>T</i> =77 K) betreiben.	nen in das Material ein.
23.	 Piezoelektrische Werkstoffe □ Die piezoelektrische Polarisation tritt nur bei Kristallen auf, die ein Symmetriezentrum besitzen. □ Der Piezoeffekt wird nicht in Metallen beobachtet. □ werden bei Temperaturen T > T_C als elektromechanische Wandler eingesetzt. 		
24.	Dotiert man Silizium (Si) mit Arsen ☐ ist die Fermi-Energie des dotierte ☐ ändert sich die Fermi-Energie de ☐ ist die Fermi-Energie des dotierte	en Si höher als im undotierten Si. es dotierten Si nicht gegenüber undotierter	n Si.
25.	Ferromagnetische Werkstoffe □ bestehen aus Atomen, die ein permanentes magnetisches Dipolmoment besitzen. □ bestehen immer aus eisenhaltigen, metallischen Legierungen. □ besitzen einen linearen Zusammenhang zwischen Induktion <i>B</i> und magnetischer Feldstärke <i>H</i> .		
26.	 Welche Aussagen zu den Polarisationsmechanismen sind richtig? □ Die Rückstellkräfte der ionischen Polarisation basieren auf elektrostatischen Bindungskräften. □ Die Rückstellkräfte der Orientierungspolarisation basieren auf der Temperatur des Stoffes. □ HDK-Keramik-Kondensatoren nutzen ausschließlich die Elektronenpolarisation 		

27.		t steigender Feldstärke <i>E</i> steigt in einem Leiterwerkstoff die Stromdichte <i>j</i> , weil die Stoßzeit der Elektronen sinkt. die Ladungsträgerbeweglichkeit abnimmt. die Ladungsträgerkonzentration durch Stoßprozesse zunimmt. die Driftgeschwindigkeit der Elektronen steigt. die effektive Masse der Elektronen abnimmt.
28.	Dei	r Zusammenhang zwischen Ladungsträgerkonzentration n und Temperatur T : $n \sim \exp\left(\frac{-W_G}{2kT}\right)$ gilt
		bei allen technischen Halbleitern. bei divalenten Metallen. bei vielen Isolatoren.
29.		e elektrische Leitfähigkeit σ von Metallen steigt mit zunehmender Temperatur. von Supraleitern sinkt kontinuierlich mit abnehmender Temperatur. von Isolatoren steigt bei sehr hohen Temperaturen. von Metalloxiden sinkt mit zunehmender Temperatur. von Halbleitern steigt im intrinsischen Bereich mit zunehmender Temperatur.
30.		elche der Aussagen über ferromagnetische und ferroelektrische Werkstoffe sind richtig? Ferroelektrische und ferromagnetische Werkstoffe zeigen unterhalb der Curie-Temperatur eine ausgeprägte Hysterese.
		Ferroelektrische und ferromagnetische Bauelemente bestehen aus oxidkeramischen Werkstoffen. Sie werden durch einen Sinterprozess hergestellt. Beim Überschreiten der Curie-Temperatur verschwinden in einem ferroelektrischen Material die permanenten Dipole, während in einem ferromagnetischen Material nur die Ordnung der Dipole gestört wird.

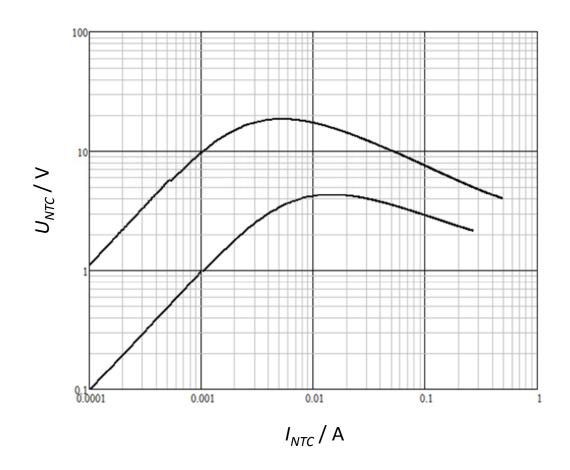
Punkte AWF

Nachname	Vorname(n)	Matrikelnummer

Teil 2: Rechenaufgaben (30 Punkte)

Rechenaufgabe A1: NTC

a) Im folgenden Diagramm sind die statischen Strom-Spannungs-Kennlinien eines keramischen Heißleiters in doppeltlogarithmischer Darstellung aufgetragen. Das Bauteil wird zunächst in ruhender Luft (T_L = 330 K) betrieben, danach wird es in ein kaltes Wasserbad (T_W = 250 K) getaucht und erneut eine Kennlinie aufgenommen. Bestimmen Sie die Koeffizienten A und B zur Beschreibung der Heißleiter-Temperaturabhängigkeit gemäß der Beziehung $R(T) = A \exp(B/T)$. (2 Punkte)



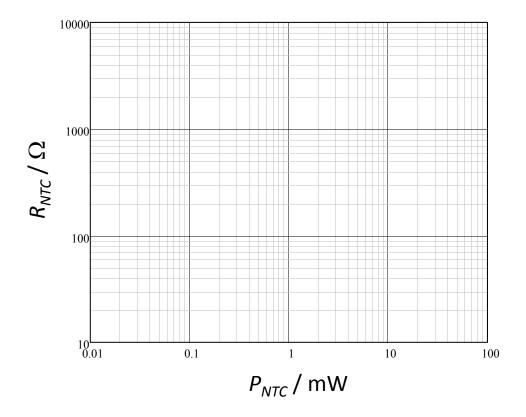
A = $B =$		Punkte A1.a
Passive Bauelemente Klausur 25. Februar 2011	Seite 8/22	Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Institut für Werkstoffe der Elektrotechnik

Nachname	Vorname(n)	Matrikelnummer

b) Welchen maximalen Heißleiterstrom I_{max} kann man zulassen, damit der Heißleiter noch als Temperatursensor eingesetzt werden kann? Bitte begründen Sie kurz! Ermitteln Sie zudem den technischen Temperaturkoeffizienten α_R des Heißleiters aus den gegebenen Diagrammwerten (bezogen auf T_L). (2 **Punkte**)

$I_{max} =$	Punkte A1.b
$\alpha_R =$	

c) Skizzieren Sie "grob" den Verlauf des Heißleiterwiderstandes R_{NTC} als Funktion der elektrischen Leistung P in das untenstehende Diagramm. Verwenden Sie hierzu die in Aufgabenteil a) gegebene Kennlinie bei Betrieb an Luft. (Lösung der Aufgabe ohne Rechnung möglich). (2 Punkte)



Nachname	Vorname(n)	Matrikelnummer

d) Ein neuer Heißleiter mit den Kennwerten $A=0.01~\Omega$ und $B=4000~\mathrm{K}$, der Oberfläche $A_O=10^{-4}~\mathrm{m}^2$ und der Wärmekennzahl $\alpha_L=5~\mathrm{W/(m^2K)}$ soll zur Spannungsbegrenzung bei einer Umgebungstemperatur von $T_U=330~\mathrm{K}$ eingesetzt werden. Berechnen Sie die Temperatur T_m , wenn die über dem Bauteil abfallende Spannung maximal wird, und geben Sie den Wert der maximalen Spannung an. (4 Punkte)

	Punkte A1.d
$T_m =$	
$U_{max} =$	

Nachname	Vorname(n)	Matrikelnummer

Rechenaufgabe A2: Kristallstrukturen, Thermodynamik und Defektchemie

Bariumtitanat (10 Punkte)

Bild 1 zeigt die kubische Elementarzelle des Ionenkristalls Bariumtitanat (BaTiO₃) bei $T_1 = 400 \text{ K}$.

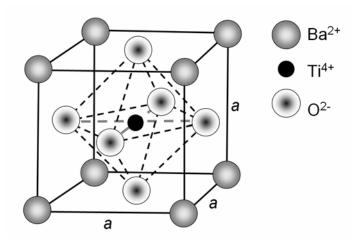


Bild 1

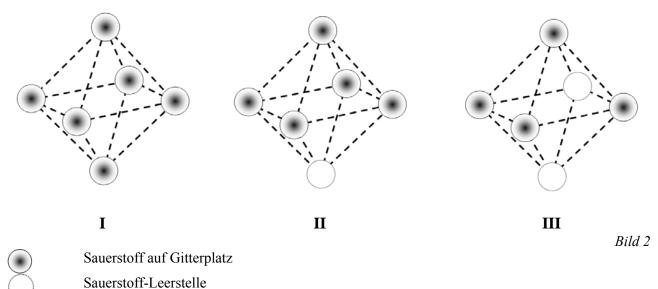
a) Betrachten Sie nur die Barium- und Sauerstoff-Ionen (vernachlässigen Sie das sehr kleine Titan-Ion) und benennen Sie die dargestellte Kristallstruktur. Welchen Raumerfüllungsgrad besitzt sie? Wie sind die Barium-Ionen zueinander koordiniert? (3 Punkte)

Hinweise:

Die Gitterkonstante beträgt a=0,3996 nm. Für den Zusammenhang zwischen Gitterkonstante a und den Ionendurchmessern d ($d\equiv d_{\mathrm{Ba}^{2+}}\approx d_{\mathrm{O}^{2-}}$) gilt näherungsweise: $a=\sqrt{2}\cdot d$.

	Punkte A2.a
Kristallstruktur:	
Raumerfüllungsgrad:	
Koordinierungszahl der Barium-Ionen:	

b) In Bild 2 skizziert ist ein Ausschnitt der in Bild 1 gezeigten Elementarzelle. Dargestellt ist nur das Oktaeder aus Sauerstoff-Ionen. Bei erhöhten Temperaturen baut sich Sauerstoff aus dem Gitter aus.



Welcher der Zustände I, II oder III ist bei der Temperatur $T_2 = 726,85$ °C der wahrscheinlichste? Berechnen Sie hierzu die Freie Energie $F = E - T \cdot S$ jedes Zustands (die Freie Energie des idealen Oktaeders I wird als $F_{\rm I} = 0$ angenommen). (3 **Punkte**)

Hinweise:

Nehmen Sie dabei an, dass alle N Kristallgitterplätze energetisch gleichwertig und alle gezeigten Leerstellen-Positionen ebenfalls energetisch gleichwertig sind.

Für die Erzeugung einer Schottky-Leerstelle muss jeweils der Energiebetrag E_0 aufgewendet werden.

Für die Entropie S gilt: $S = k \cdot \ln \Omega$. Ω ist dabei die Anzahl der Realisierungsmöglichkeiten, n Teilchen auf

N Plätze zu verteilen:
$$\Omega = \binom{N}{n} = \frac{N!}{(N-n)! \cdot n!}$$

Konstanten:

$$E_0 = 0.14 \text{ eV}$$

 $k = 8.617 \cdot 10^{-5} \text{ eV/K}$

$$F_{\rm I} = 0 \; {\rm eV}$$

$$F_{\rm II} =$$

$$F_{\rm III} =$$

$$\Rightarrow Der \; wahrscheinlichste \; Zustand \; ist:$$

Nachname	Vorname(n)	Matrikelnummer

Bild 3 zeigt die Elementarzelle des ferroelektrischen BaTiO₃ bei $T_3 = 293$ K. In der gezeigten tetragonalen Phase hat das Titan-Ion wie skizziert zwei gleichberechtigte Positionen.

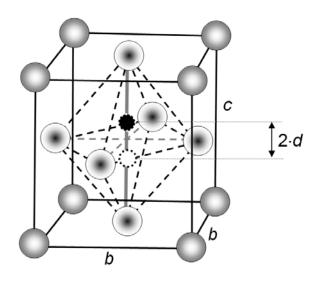


Bild 3

Spontane Polarisation:

 $P_S = p \cdot \frac{N}{V}$

p: Dipolmoment*N*: Anzahl der Dipole

V: Volumen

Gegebene Zahlenwerte:

Gitterkonstante b = 0,3992 nm Gitterkonstante c = 0,4036 nm

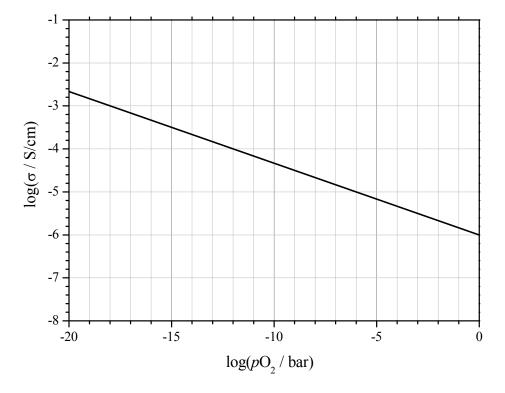


zwei gleichberechtigte Positionen des Titan-Ions

c) Betrachtet wird im Folgenden eine ferroelektrische Domäne von BaTiO₃. An ihr wird eine spontane Polarisation $P_S = 0,11$ As/m² gemessen. Nehmen Sie vereinfachend an, dass die Asymmetrie in der Ladungsverteilung nur durch eine Verschiebung des Ti⁴⁺-Ions um die Strecke d aus dem Zentrum heraus entsteht (s. Bild 3). Berechnen Sie hieraus die Strecke d, um die das Ti⁴⁺-Ion aus dem Zentrum heraus verschoben ist. (2 **Punkte**)

d) Skizziert ist in Bild 4 die elektrische Leitfähigkeit σ von undotiertem BaTiO₃ bei der Temperatur $T_4 = 1000$ °C als Funktion des Sauerstoffpartialdruckes pO_2 der umgebenden Atmosphäre.





Das Material wird einer Atnosphäre mit einem Restsauerstoff von $pO_2 = 10^{-6}$ bar bei $T_1 = 1000$ °C ausgesetzt. Dabei stellt sich eine Sauerstoffleerstellenkonzentration $\left[V_0^{\bullet\bullet}\right] = 2,9 \cdot 10^{13} \, \text{cm}^{-3}$ ein. Berechnen Sie hieraus einen Wert für die Elektronenbeweglichkeit μ_n . (2 **Punkte**)

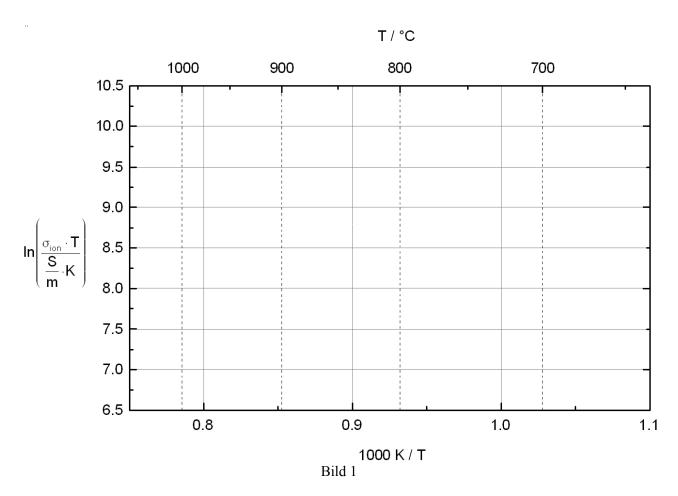
Hinweise: Die Elektronenbeweglichkeit μ_n werde als konstant angenommen. Alle Defekte sind bei den gegebenen Temperaturen als vollständig ionisiert zu betrachten. Gehen Sie von der Elektroneutralitätsbedingung ENB: $2[V_0^{\bullet\bullet}] = n$ (n: Elektronenkonzentration) aus und nehmen Sie an, dass μ_n wesentlich größer als $\mu_{V_0^{\bullet\bullet}}$ ist.

	Punkte A2.d
μ_n =	
$\mathcal{F}^{\mathbf{c}}_{n}$	

Nachname	Vorname(n)	Matrikelnummer
	ing soll als Elektrolytwerkstoff in einer Hoc eitfähigkeit in dem Werkstoff lässt	
a) Welche Art von Ladungsträgern lieg	t in dem Werkstoff vor? Welchen Wert nin	mmt $ z_{ion} $ an? (2 Punkte)
		Punkte A3.a
Ladungsträger:		. 3.111.07.6.12
$ z_{\rm ion} =$		
b) Geben Sie die Gleichung für den Ein (2 Punkte)	abau von Y ₂ O ₃ ins Zirkondioxidgitter in de	er Kröger-Vink Notation an.
Einbaugleichung:		Punkte A3.b

Die Temperaturabhängigkeit der ionischen Leitfähigkeit von YSZ lässt sich über die Gleichung: $\sigma_{ion}(T) = \frac{A}{T} \cdot \exp\left(-\frac{E_A}{kT}\right)$ mit den Parametern $E_A = 0.917$ eV und $A = 9.43 \cdot 10^7$ S/m·K beschreiben (Hinweis: $k = 8.617 \cdot 10^{-5}$ eV/K).

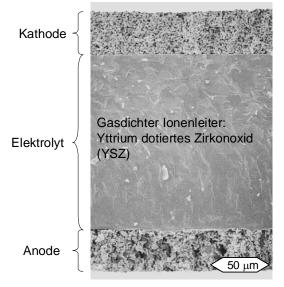
c) Tragen Sie in das Diagramm in Bild 1 die ionische Leitfähigkeit für den Temperaturbereich zwischen 700 und 1000 °C ein. (2 Punkte)



Nachname	Vorname(n)	Matrikelnummer				

Punkte A3.c

Mit dem Elektrolytwerkstoff wird eine Hochtemperatur-Brennstoffzelle bestehend aus Elektrolyt und zwei Gasdiffusionselektroden aufgebaut (Bild 3). Die Zelle hat eine aktive, stromdurchflossene Fläche von $A=100~\rm cm^2$ und wird bei einer Temperatur von 750 °C betrieben. Die Dicke des Elektrolyten beträgt 150 µm. Ihr elektrisches Verhalten sei durch das in Bild 3 dargestellte Gleichstromersatzschaltbild bestehend aus einer idealen Spannungsquelle ($U_L=1,2~\rm V$), dem Elektrolytwiderstand $R_{Elektrolyt}$ und dem Polarisationswiderstand der Elektroden $R_{Pol}=8~\rm m\Omega$ beschreibbar.



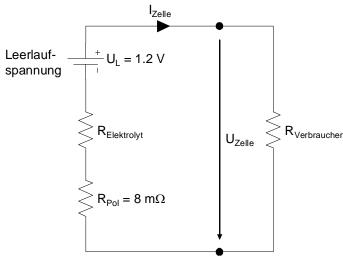


Bild 3

d) Bei welcher (4 Punkte)	Stromstärke	I_{Zelle}	gibt	die	Zelle	die	maximale	Leistung	P_{max}	ab?	Berechnen	ı Sie	P_{\max} .
$I(P_{\text{max}}) =$												Punkte	A3.d
$P_{\text{max}} =$													

Nachname						Vo	ornan	ne(n)			Matrikelnummer							
							•						•					
											;							
				:														
			:	: : :	:		: : :	:			:				:			
					· ·		· ·				· · ·							
					- - - - -													
						· 					· · ·	 						
			: 	: :			:	: : :		: 	: 				: 			
			: 	: :		: :	: 	: 			: 				: 			
						:			: 			 			- 			
			: 		. – – – – – .			: 	: 									
			:	:		:	: 	: :			: 				: 			
								: 	: 		- 	 						
			: :	:	;	÷	: :	.	; :		÷				 :			
			:			:	: :	:	:		; 							
				 - -				·			·							
						:												
			:	:		:			:									
				: : :				:			: : :							
							: : :			: : :		 						
			: :	: : :	· · ·			: :	: :		: : :	 			: : :			
				:				:			· · ·							
			· 	· · ·	- - 				: :			-				Frrei	chte Pu	ınkte
												 					J. 1.0 T C	

